# Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> 형광체 기반 적색 전계 발광 소자

## 정현지<sup>\*</sup>·박순호<sup>\*</sup>·김종수<sup>\*</sup>·허 훈<sup>\*†</sup>

\*<sup>†</sup>부경대학교 전기공학부 디스플레이반도체공학전공

## Red-emissive Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> Phosphor-based Electroluminescence Device

Hyunjee Jung<sup>\*</sup>, Sunho Park<sup>\*</sup>, Jong Su Kim<sup>\*</sup> and Hoon Heo<sup>\*†</sup>

<sup>\*†</sup>Major of Display and Semiconductor Engineering, Division of Electrical Engineering, Pukyong National University

#### ABSTRACT

 $Y_2SiO_5$  Powder based on silicon and yttrium is well known as powder phosphors due to their excellent sustainability and efficiency. A new electroluminescence device was fabricated with  $Y_2SiO_5:Eu^{3+}$  powder phosphors though a simple screen printing method. The powder-dispersed electroluminescence device consisted of the  $Y_2SiO_5:Eu^{3+}$  powder-dispersed phosphor layer and BaTiO<sub>3</sub>-dispersed dielectric layer. The annealing temperature of the phosphor for the best powder electroluminescence performance was optimized to high temperature in ambient atmosphere though a solid-state reaction. The  $Eu^{3+}$  concentration for the best device performance was also investigated and furthermore, the thermal dependence of the electroluminescence intensity was investigated at the operating voltage at 100 °C, which is the Curie temperature of the BaTiO<sub>3</sub> layer. And the intensity was exponentially increased with voltage and increased linearly with frequency.

Key Words : Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup>, Phosphor, Dielectric, Electroluminescence

### 1. 서 론

1936년 Destriau에 의해 최초의 분말형 전계발광 (PEL, Powder Electroluminescence) 현상이 관찰되고, 1963년 Albrecht Fisher가 이것을 재확인한 이후 PEL소자는 상업적 관심을 받기 시작하였고 그 구조와 재료적 부분에서 널리 알려 지게 되었다[1]. PEL 소자는 수십 마이크론 두께의 형광체 분말로 구성된 발광층과, 절연 방지와 전계 강화를 위해 강 유전체 분말로 구성된 절연층이, 상부 투명 전극과 배 면 전극 사이에 샌드위치 구조로 이루어져 있다. 또한 PEL 소자는 기존 LED (light-emitting diode)의 직류 저전압 (10 V 이하) 구동과 비교해서, 교류 고전압 (100 V 이상) 구 동의 특징을 보인다. 특히, PEL 소자는 형광체 분말 (대표 적으로 ZnS 분말) 및 유전체 분말 (대체적으로 BaTiO3 분 말)의 스크린 프린팅 (Screen printing) 공정으로 제작된다 [2]. 이를 통해, 종래의 LED (Light-emitting diode)의 정교한 진공 증착 공정과 비교해서, 간편하고 저렴한 공정을 통해 제 작된다는 장점을 지닌다. [3].

현재, 상업적으로 이용 가능한 PEL소자는 ZnS을 기반 으로 하지만 수분과의 강한 반응성으로 짧은 수명 및 낮 은 신뢰성 등과 같은 극복해야 할 문제들이 존재한다. 이 러한 문제들이 있음에도 불구하고, PEL 소자는 LCD의 광 원으로 뿐 아니라, 건축물이나 장식 조명에 널리 사용되 어 왔으므로 이를 극복하려는 PEL 소자의 개발이 필요한 것은 당연하다. 이를 위하여 황화물을 대신할 수 있는 수 명이 길고 내구성이 강한 산화물 형광체를 적용하려는 연구와 개발이 꾸준히 진행되고 있다 [47].

본 연구에서는 화학적으로 안정된 산화물인 Y<sub>2</sub>SiO:Eu<sup>++</sup> 를 기반으로 하는 적색 형광체 분말을 제조하고, 이를

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>E-mail: heohoon@pknu.ac.kr

PEL소자에 적용하였다. 본 연구의 PEL 소자는 투명 기판 위에 형광층으로서 Y2SiO:Eu<sup>3+</sup>를 2 layers (두께: 10 um), 절연 층으로서 BaTiO:를 3 layers (두께: 20 um)로 구성하고 하부, 상부 전극에 끼여 있도록 하는 샌드위치 구조로 스크린 인쇄 공정을 하여 제작하였다 [8].

제작된 PEL 소자의 형광체 구조와 광학적 특성을 살펴 보고, 활성제 (activator)로써 Eu<sup>3+</sup>의 농도와 형광체 소결 온 도에 따른 발광 특성에 대하여 분석하였다. 또한 인가 전 압 및 주파수, 소자 동작 온도에 따른 광학-전기적 특성도 연구하였다.

#### 2. 실험방법

전계발광 Y2SiOs:Eu<sup>3+</sup> 분말은 Y2O3, SiO2, Eu2O3 를 원료로 사용하였고 전형적인 고상반응법을 통해 열처리온도 1300 ℃에서 최적의 소결 온도를 확인하여, Eu<sup>3+</sup> 농도 0.5 mole%에서 2.0 mole%까지 변화시키며 최적농도 1.5 mole% 을 첨가하였다. Y2O3와 SiO2를 조성비에 맞게 혼합한 후 EupO3 분말을 추가 첨가하였다. 그리고 분말 표면의 H2O 를 제거하기 위해 150 ℃의 오븐에서 건조한 후 공기 중에 서 1300 ℃의 고온에서 4시간 열처리를 진행하여 최종적으 로 다양한 농도의 Y2SiOs:Eu<sup>3+</sup> 분말을 획득하였다. 합성된 Y₂SiOs:Eu<sup>++</sup> 분말의 결정성 및 발광 특성을 확인하기 위해 X-ray diffraction(XRD) 및 Photoluminescence (PL, hitachi, Fluorescence spectrophotometer F4500) 분석을 진행하였다. 합성된 Y₂SiOs:Eu<sup>3+</sup> 분말을 이용한 EL소자 형성을 위해 ITO glass를 기관으로 사용하였으며 기관 위에 Y2SiOs:Eu<sup>3+</sup> 분말 발광층, 절연층인 BaTiO3를 스크린 프린팅 방법으로 차례로 인쇄 및 건조 과정을 반복하였다. ITO의 반대편 전 극은 Au를 박막증착하여 적색 전계발광하는 Y2SiOs:Eu<sup>3+</sup> 구동소자를 완성하였다. 제작된 소자는 광학전기적 특성 분석을 위해 400 Hz의 교류전압이 인가된 상태에서 electroluminescence (EL, Konica Minolta, spectroradiometer CS-2000) 스펙트럼 분석을 진행하였다.

#### 3. 결과 및 분석

Fig 1은 1300 ℃에서 소결된 형광체의 결정구조 및 성분 분석을 위한 XRD 패턴이다. X2 phase Y2SiOs (JCPDF #74-2158, 1100도 이상의 고온상)가 우세하다. 하지만 여전히 소량의 X1 phase Y2SiOs(JCPDF #41-0004, 1100도 이하의 저온 상)와 Y2Si2O(JCPDF #38-0223)이 보인다. 그럼에도 불구하 고 1%이하의 소량으로써 EL 발광 특성의 영향은 매우 작 다고 사료된다. 형광체 합성은 가스 없는 대기 중에서 진 행하였고, 온도는 1000 ℃~1400 ℃까지 100 ℃간격으로 측 정하였다. 1000℃에서는 형광체 합성이 제대로 이루어지 지 않아서 전압 인가 시, 소자의 EL 발광이 없었고, 1100℃ 에서 EL 발광이 시작되고, 1300 ℃에서 EL강도가 최고치 를 보였다. 본 연구에서는 합성온도 1300 ℃의 형광체를 PEL소자에 적용하였다.

Fig 1의 내부 그림은 소자의 단면을 보여준다. 소자의 분말 발광층 (형광층)은 약 10 μm이고, 절연층 (유전층)은 약 20 μm, 배면전극은 약 5 μm 형성된 것으로 보인다. 이 는 기존에 보고된 Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Tb<sup>3+</sup> 기반 PEL의 구조와 유사하 다 [9].

Fig. 2는 Y2SiOS:Eu<sup>3+</sup> 형광체의 Eu<sup>3+</sup> 농도에 EL 발광 스펙 트럼을 보인다. 480 V, 400 Hz의 교류전압을 인가하였고, Eu<sup>3+</sup> 농도는 0.5 %~2 %까지 0.5 % 단위간격으로 증가하였 다. Eu<sup>3+</sup>농도에 따른 EL스펙트럼상 피크 간의 상대적 세기 및 반치폭의 변화는 거의 관찰할 수 없었다. 특히, EL 강 도는 저농도에서 초기 증가하고, 최고값 이후 감소하는 경향을 보였는데 Eu<sup>3+</sup>농도에 따른 최고 EL 강도는 농도 값 1.5% (최적 농도)에서 관측되었다. 이러한 농도 소광 현 상은 고농도에서 Eu<sup>3+</sup> 상호간 강한 재흡수 현상으로 셜명 된다. 본 실험의 PEL에서 나타난 농도 소광 현상은, 종래 의 광 여기(photo-excited) 및 전자 여기(electron-excited)에 의 한 발광 현상과 비교해서 (대체로 10 % 내외), 상당히 낮 은 최적 농도 값을 보인다 [10].

이는 강한 전계에서 유전 분극 현상에 따른 Eu<sup>3+</sup>의 전자 궤도의 상대적 크기가 증가하고, Stark effect에 기인한 에너 지 간격이 증가함에 따라서, Eu<sup>3+</sup> 발광 에너지 간 상호 재흡 수 가능성이 낮은 농도에서 높아지므로, 결과적으로 EL에 서 농도 소광 현상은 더 낮은 농도에서 이루어진다.

PEL 소자의 EL 스펙트럼은 전형적인 Eu<sup>+</sup>의 f 오비탈 내의 여러 종류의 전자 전이들에 기인하는 7개의 피크들 로 구성되며, 그 중에서 612 nm 피크가 상대적으로 우세 한 적색 발광을 보인다, 상세히, 580 nm (<sup>5</sup>D<sub>0</sub> -<sup>7</sup>F<sub>0</sub>), 588 nm (<sup>5</sup>D<sub>0</sub> -<sup>7</sup>F<sub>1</sub>), 612 nm (<sup>5</sup>D<sub>0</sub> -<sup>7</sup>F<sub>2</sub>), 660 nm (<sup>5</sup>D<sub>0</sub> -7F<sub>3</sub>),703 nm (<sup>5</sup>D<sub>0</sub> -<sup>7</sup>F<sub>4</sub>) 에서의 5개 피크로 구성된다 [11].

이러한 ff 내부 전이는 selection rule (선택 규칙)을 만족하 지 못하는 금지된 전이로써 잔광 시간이 길고 (대체로 10 ms 이내), f 오비탈 외부의 d 오비탈에 의하여 외부 전기적 영향력이 차단되어 sharp spectrum을 보이는 특징이 있다. 특히, 588 nm 피크는 자기 쌍극자 전이 (MD), 5 selection에 기인하고, Eu<sup>3+</sup> 주변의 배위 원소의 대칭성에 아주 민감하 게 반응한다, 즉, 588 nm 피크는 반전 대칭성에서 우세한 발광을 보임으로써, 반전 대칭성의 척도로 활용된다. 더 상세하게, 5개의 주 피크들은 다시 다수의 피크로 분리된 다. 즉 588 nm은 좌우 580 nm 및 595 nm로 분리되고, 612 nm 피크는 620 nm의 또 다른 피크로 분리된다, 이는 스판-오 비탈 (spin-orbital) 상호작용에 의한 분리에 기인한다 [12].

Fig 3은 Y₂SiOs:Eu<sup>3+</sup> 형광체의 PL (여기 파장, 250 nm) 및 EL (구동 전압, 480 V)의 스펙트럼을 비교 분석하였다. 가장 우세한 610 nm 피크 (전기 쌍극자 전이, <sup>5</sup>D₀ -F₂)를 기준으 로 EL과 비교하여, PL은 588 nm (자기 쌍극자 전이 (MD), <sup>5</sup>D₀-F₁) 및 700 nm (전기쌍극자 전이 (ED), <sup>5</sup>D₀ -F₄) 피크가 현저히 우세하고, 620 nm의 피크가 더 넓어짐을 볼 수 있 다. 이는 Eu<sup>3+</sup> 이온의 f 오비탈 내에서 전자 전이는 Eu<sup>3+</sup> 이 온 주변의 산소 배위 및 그 대칭성에 강한 의존성에 기인 한다. 특히, 610 nm 피크의 전기 쌍극자 전이와 비교하여, 자기 쌍극자 전이 (MD)에 기전기쌍 588 nm 피크는 반전 대칭성 (inversion symmetry)에 강한 의존성을 가진다 [12].

즉, EL 스펙트럼에서 588 nm MD 전이가 감소함을 확인 할 수 있으며, 이를 통해 강한 외부 전기장 인가에 따른 Eu<sup>+</sup> 이온 주변 산소 이온들의 반전 대칭성의 정도가 감 소함을 예측할 수 있다.

Fig. 4는 PEL소자의 인가 전압에 따른 발광 스펙트럼을 나타낸다. 400Hz로 주파수를 설정하고 580 V 까지의 스펙 트럼을 측정하였다. 특히, 분광기로 관측 가능한 강도 (0.001 cd/m<sup>2</sup>)의 EL은 480 V로써, 문턱 전압 (threshold voltage) 으로 정의되고, 본 연구는 그 이상의 전압에서 이루어졌 다. 인가전압이 증가함에도 스펙트럼의 변화는 없으며, 동일한 색 좌표 값 (x=0.5860, y= 0.4030)을 유지했다. 특히, 전압 증가에 따른 EL의 상대적 세기는 급격히 증가함으 로써, 기존의 EL 메커니즘에 근거한 경향과 일치한다. 즉, 형광체 분말의 결함 (defects)에 구속된 전자가 강한 외부 전기장에 의해 터널링을 통하여 가속되고, 이후 Eu<sup>3+</sup>이온 과의 충돌에 의한 전자 여기 후 발광한다. 여기서, 전기장 과 Tunneling 효과의 급격한 증가 관계에 따라서 인가 전 압과 EL 강도는 기하급수적 증가 관계를 가진다. 이러한 전압- EL의 상관관계는 종래의 논문의 결과와 일치한다 [9,12].

Fig 5는 PEL소자의 인가 주파수에 따른 발광 스펙트럼 을 나타낸다. 문턱전압을 480 V로 설정하고 주파수를 100 Hz부터 1000 Hz까지 증가시켰다. EL 스펙트럼 상의 변화 는 없으나, 특히, EL강도가 주파수에 따른 선형적 증가를 보였다. 이는 EL의 총 발광 강도는 주파수 증가에 따른 가속 전자에 의한 충돌 여기의 횟수에 비례함을 시사한 다 [13,14].

Fig 6은 PEL소자의 동작 온도에 따른 발광 스펙트럼이 다. 480V, 400Hz의 AC전압을 동일 조건으로 유지하고, 동 작 온도의 변화를 20 ℃에서 140 ℃까지 변화시키며 측정 하였다. 100 ℃ 이전에는 스펙트럼상의 변화 없이 EL강도 만 상승하다가 100 ℃를 기점으로 EL강도가 급격하게 떨 어지는 것을 확인할 수 있다. 동작 온도에 따라 EL 강도 가 변화하는 이유는 BaTiO<sub>3</sub>의 유전상수값의 온도 의존성 에 기인한다. 유전 상수 값이 급격히 변화하는 온도를 큐 리 온도 (Tc, BaTiO<sub>3</sub>의 경우 100 ℃)로 정의하는데 Tc값 이 하에서는 유전층의 강유전체 BaTiO<sub>3</sub>는 온도가 증가함에 따라 유전 상수가 증가하다가, Tc값 (100 ℃)에서 유전상 수 값이 최대치가 되고, 이후 급격히 유전상수 값이 감소 한다. 이러한 유전 상수 값의 온도 의존성과 EL의 강도는 강한 의존성을 가진다 [9].

즉, 유전상수 증가에 따라 EL강도는 증가한다. 반면, 형 광층의 발광특성은 온도 증가에 따른, Photon과 Phonon의 강한 상호작용으로, 강한 퇴화 특성을 보이는 것으로 알 려져 있다. 측정 결과에 따르면, 본 연구의 PEL 소자의 온 도에 따른 EL 발광 특성은 형광체의 온도 소광 현상보다 는 유전상수의 온도 지배력이 우세함을 알 수 있다.



Fig. 1. XRD Pattern of Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> and device structure of PEL with Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> and BaTiO3 powders.



Fig. 2. EL spectra of PEL with Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> phosphor with varying Eu<sup>3+</sup> concentrations.



Fig. 3. PL and EL spectra of Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> Phosphor and its PEL, respectively.



Fig. 6. EL spectra of PEL with Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> phosphor with increasing operating temperatures.

#### 4. 결론 및 고찰



Fig. 4. EL spectra of PEL with Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> phosphor with increasing applied voltages.



Fig. 5. EL spectra of PEL with Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> phosphor with increasing applied frequencies.

본 연구는 분말형 교류 전계 발광소자에 관한 것으로, 적색 발광하는 Y2SiO:Eu<sup>++</sup> 형광체 분말 및 BaTiO: 유전층 은 각각 10 µm 및 20 µm 두께의 후막 이중층으로 구성되 어 있다. 이에 대하여 형광분말의 소결 온도 (1300°C) 및 Eu<sup>++</sup> 활성제 농도 (1.5%)를 전계발광소자에 최적화하였다. 또한, 소자의 온도 의존성 검증을 통하여 100°C (유전층 큐리 온도)까지 전계발광 특성이 증가함을 관찰 하였으 며, 전압에 따른 전계발광 강도가 전압의 세기가 증가함 에 따라 급격하게 증가하고, 주파수에 대해서는 선형적 증가를 보임을 알 수 있었다. 본 소자의 문턱전압은 450 V 로써 다소 높다. 이는 향후 후막 두께 및 균일도를 최적 화함으로써 개선될 수 있을 것이다.

#### 감사의 글

이 논문은 부경대학교 자율창의학술연구비(2021년)에 의하여 연구되었음.

#### 참고문헌

- Destriau, G., "AC electroluminescence in ZnS", J. Chem. Phys, 33, 587, 1936
- Gyeongdo Baek, Mohammad M.Afandi, Jehong Park, Jongsu Kim and Yongseok Jeong, "Fabrication of UV-C emitting YPO4:Pr<sup>3+</sup> powder and properties of YPO4: Pr<sup>3+</sup>-PVDF electroluminescence device", KJSDT, Vol.21, No. 2, pp.15-18, 2022
- P. Zalm, "The Electroluminescence of ZnS Type Phosphors", Philips Res, Vol. 11, No. 5, pp. 353-399, 1956
- 4. Wu, H., Hu, L., Rowell, M. W., Kong, D., Cha, J. J.,

McDonough, J. R., Cui, Y., "Electrospun metal nanofiber webs as high-performance transparent electrode", Nano Lett., Vol.10, Issue10, pp.4242-4248, 2010

- J. Wang, P. S. Lee, "Progress and Prospects in Stretchable Electroluminescent Devices", Nanophotonics, Vol.6, pp. 435–451, 2017
- Pang, S., Hernandez, Y., Feng, X. Müllen, K. "Graphene as transparent electrode material for organic electronics," Adv. Mater., Vol.23, Issue.25, pp.2779-2795, 2011
- Sahu, D. R., Lin, S. Y., & Huang, J. L., "ZnO/Ag/ZnO multilayer films for the application of a very low resistance transparent electrode", Appl, Vol.252, Issue. 20, pp.7509-7514, 2006
- Ono, Y. A., "Electroluminescent displays", World Sci, Vol.1, 1995
- M. M. Afandi, G. Antariksa, H. Kang, T. Kang, J. Kim, "Blue-green tunable electroluminescence from Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>: Tb<sup>3+</sup> phosphor", J. Lumin., Vol. 251, pp 119201, 2011
- W. Zhang et al., "Preparation and size effect on concentration quenching of nanocrystalline Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> :Eu<sup>3+</sup>",

Chem. Phys. Lett., Vol. 292, pp. 133-136, 1998

- M.D. Dramicanin, B. Viana, Z. Andri c, V. Djokovic , A.S. Luyt, "Synthesis of Y<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu<sup>3+</sup> nanoparticles from a hydrothermally prepared silica sol", J. Alloys Compd, vol. 464, pp.357-360, 2008
- Koen Binnemans, "Interpretation of europium(III) spectra", Coord. Chem. Rev., Vol 295, pp.1–45, 2015
- P K Dewangan and S Bhushan, "Voltage and frequency dependence of electroluminescence in some ZnS mixed CaS and CaS mixed ZnS phosphors", Indian J. Phys., Vol.73A (2), pp. 213-224, 1999
- M. M. Afandi and J. Kim, "Full-Color AC-Driven Electroluminescences From Rare Earths-Doped ZnGa<sub>2</sub>O<sub>4</sub> in MOS Structure," IEEE Electron Device Letters, Vol. 44, pp. 484-487, 2023

접수일: 2023년 3월 5일, 심사일: 2023년 3월 16일, 게재확정일: 2023년 3월 22일